



BERGISCHE
UNIVERSITÄT
WUPPERTAL

BERGISCHE UNIVERSITÄT WUPPERTAL

FORTGESCHRITTENEN PRAKTIKUM

Rastertunnelmikroskopie

Verfasser:

Henrik JÜRGENS

Frederik STROTHMANN

Tutor:

Vitali PORSHYN

Abstract:

Mithilfe eines Rastertunnelmikroskops wird die Struktur verschiedener Materialien analysiert, indem deren Oberfläche in verschiedenen Modi abgerastert wird.

Bereich	max. %	+ / 0 / -	erreicht %
Einleitung & Theorie	15		
Durchführung	70		
Auswertung			
phys. Diskussion			
Zusammenfassung			
Formales	15		
Note			

2. Oktober 2015

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Theorie	2
2.1	Tunneleffekt	2
2.2	Oberflächenrauheit	3
2.3	Struktur der Proben	4
2.3.1	Graphit	4
2.3.2	Gold	5
3	Versuchsaufbau	5
3.1	Betriebsmodi	7
3.1.1	Constant Current Mode	7
3.1.2	Constant Hight Mode	8
4	Versuchsdurchführung und Auswertung	9
4.1	Graphit	9
4.1.1	Rauheit	10
4.1.2	Gitterstruktur und Elektronendichteverteilung	11
4.1.3	Mittlerer Atomabstand	13
4.2	(111)-Goldschicht	16
4.2.1	Rauheit	16
4.2.2	Monoatomare Stufen und Gitterdefekte	18
4.3	Diskussion	20
5	Fazit	20
6	Anhang	21

1 Einleitung

In diesem Versuch werden Oberflächen verschiedener Proben mittels Rastertunnelmikroskopie auf deren Gitterstruktur und morphologische Eigenschaften untersucht. Elektronendichte, Oberflächenrauheit und die atomare Gitterstruktur können mit dem Rastertunnelmikroskop (RTM) analysiert werden. Der quantenmechanische Tunneleffekt wird genutzt, um leitende Materialien zu untersuchen. Indem zwischen einer einatomigen Platin-Iridium-Elektrode und der zu untersuchenden Probe eine Potentialdifferenz angelegt wird, kommt es abhängig von der Entfernung der Pt-Ir-Elektrode zur Probe und dessen Elektronendichte zu einem Tunnelstrom, welcher Rückschlüsse auf die Struktur der Probe erlaubt. Die Elektronendichte der Oberfläche kann durch systematisches Abrastern der Probe erfasst werden, sodass mithilfe verschiedener Modi (CC und CH: Constant Current und Constant Height) ein Bild der Materialoberfläche entsteht.

2 Theorie

In diesem Versuchsteil werden die für diesen Versuch wichtigen theoretischen Grundlagen erklärt.

2.1 Tunneleffekt

Der Tunneleffekt, auf dem die Funktionsweise des RTM basiert, kann nichtrelativistisch mit der stationären Schrödingergleichung für Materiewellen beschrieben werden.

$$E\psi = \hat{H}\psi \quad (1)$$

Über das Korrespondenzprinzip erhält man aus dem klassischen nichtrelativistischen Hamiltonian für ein Teilchen im Potential V die Ortsdarstellung der Schrödingergleichung:

$$E\psi = \left(\frac{-\hbar^2 \Delta}{2m} + V \right) \psi \quad (2)$$

$|\psi|^2$ gibt dabei die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Teilchens im Volumenelement $dV(\mathbf{x})$ an. Der Tunneleffekt kann anhand eines einfachen Beispiels verstanden werden, indem in einer Dimension ein Potentialwall in Form eines Kastens angenommen wird. Ein veranschaulichendes Bild ist wichtiger, als ein langer Rechenweg, weshalb es vorzuziehen ist, die Lösung mit Abbildung 1 zu veranschaulichen.



Abbildung 1: Eindimensionale Schrödigergleichung mit Potentialwall in der Mitte. Zu sehen ist der exponentielle Abfall der Amplitude der Wellenfunktion, wodurch die Aufenthaltswahrscheinlichkeit hinter dem Potentialwall D^2 kleiner als A^2 ist. (vgl. [7])

Die Herleitung kann ohne Probleme auf der Seite [6] nachvollzogen werden. Die Lösung der Schrödigergleichung innerhalb der Potentialbarriere ergibt einen exponentiellen Abfall der Aufenthaltswahrscheinlichkeit mit zunehmender Eindringtiefe, wobei die Wellenlänge gleich bleibt. Damit die Elektronen während des Versuches nicht in beide Richtungen gleich stark tunneln, wird eine Potentialdifferenz zwischen Bereich (I) und Bereich (III) erzeugt, wodurch die Elektronen eine Vorzugsrichtung bekommen. Der Tunnelstrom I_{Tunnel} , die entscheidende Messgröße, ist proportional zur Tunnelwahrscheinlichkeit multipliziert mit der angelegten Spannung V_{bias} und der Zustandsdichte ρ_s bei der Fermienergie E_f . Die Differenz der Austrittsarbeiten der Materialien wird mit Φ bezeichnet, wobei z der Abstand der Sonde zum Material ist:

$$I_{Tunnel} \propto V_{bias} \rho_s(E_f) \exp \left[-2 \frac{\sqrt{2m(\Phi - E)}z}{\hbar} \right] \approx V_{bias} \rho_s(E_f) \exp \left[-1,025 \sqrt{\Phi} z \right] \quad (3)$$

Die zweite Näherung gilt, falls die Potentialbarriere $\Phi \gg E$ ist und die erste Proportionalität gilt. Die erste Proportionalität ist dabei selber eine Näherung für $2 \frac{\sqrt{2m(\Phi - E)}z}{\hbar} \gg 1$, da die nicht genäherte Tunnelwahrscheinlichkeit

$$W_{Tunnel} = \frac{1}{1 + \frac{\Phi^2}{4E(\Phi - E)} \sinh^2 \left(\frac{\sqrt{2m(\Phi - E)}z}{\hbar} \right)} \quad (4)$$

entspricht. Die starke z -Abhängigkeit wird in diesem Versuch ausgenutzt.

2.2 Oberflächenrauheit

Die Oberflächenrauheit oder kurz Rauheit ist in der Oberflächenphysik eine Größe zur Charakterisierung der Unebenheit der Oberflächenhöhe. Beschrieben wird sie mit der mittleren

betragsmäßigen Abweichung von der mittleren Oberflächenhöhe, oder mit der mittleren quadratischen Abweichung von der Oberflächenhöhe. Die Formeln sind im Zweidimensionalen, wie auch im Dreidimensionalen, auf Hyperflächen anwendbar. Für die Berechnung der Rauheit wird Formel 5 und Formel 6 für das arithmetische Mittel R_a und für das quadratische Mittel R_q verwendet.

$$R_a = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |z_i - \bar{z}| \quad (5)$$

$$R_q = \frac{1}{N} \sqrt{\sum_{i=1}^N (z_i - \bar{z})^2} \quad (6)$$

Das quadratische Mittel gewichtet größere Abweichungen stärker als das arithmetische Mittel. Der Mittelwert \bar{z} wird über Formel 7 bestimmt.

$$\bar{z} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N z_i \quad (7)$$

Zur Unterscheidung wird die mittlere Flächenrauheit im Versuch mit dem Buchstaben S benannt (S_a und S_q) und die mittlere Linienrauheit behält den Namen R (R_a und R_q).

2.3 Struktur der Proben

Alle in diesem Versuch untersuchten Materialien (Gold, Graphit und eine unbekannte Probe) sind Leiter, sie unterscheiden sich jedoch in der Konfiguration der Elektronen. Es gibt einen Unterschied zwischen der Verteilung der Elektronen in Metallen und Halbleitern. Metalle werden dabei durch das Elektronen-Gas beschrieben und somit eine homogene Verteilung angenommen. Bei der Beschreibung von Halbleitern müssen noch Bandlücken berücksichtigt werden. Da die räumliche Verteilung der Elektronen nicht homogen ist, kann aus der Ladungsverteilung die Position der Atome bestimmt werden. Es soll nun genauer auf die beiden bekannten Proben Gold und Graphit eingegangen werden.

2.3.1 Graphit

Die Graphitprobe ist ein HOPG (Highly ordered pyrolytic graphite), ein Halbleiter mit einer hcp-Gitterstruktur. In Abbildung 2 ist die Gitterstruktur des Graphit zu sehen. In einer Ebene werden die Kohlenstoffatome aufgrund der sp^2 -Hybridisierung stark durch kovalente Bindungen zusammengehalten. Zwischen den Ebenen werden die Kohlenstoffatome nur von Van-der-Waals-Kräften zusammengehalten.

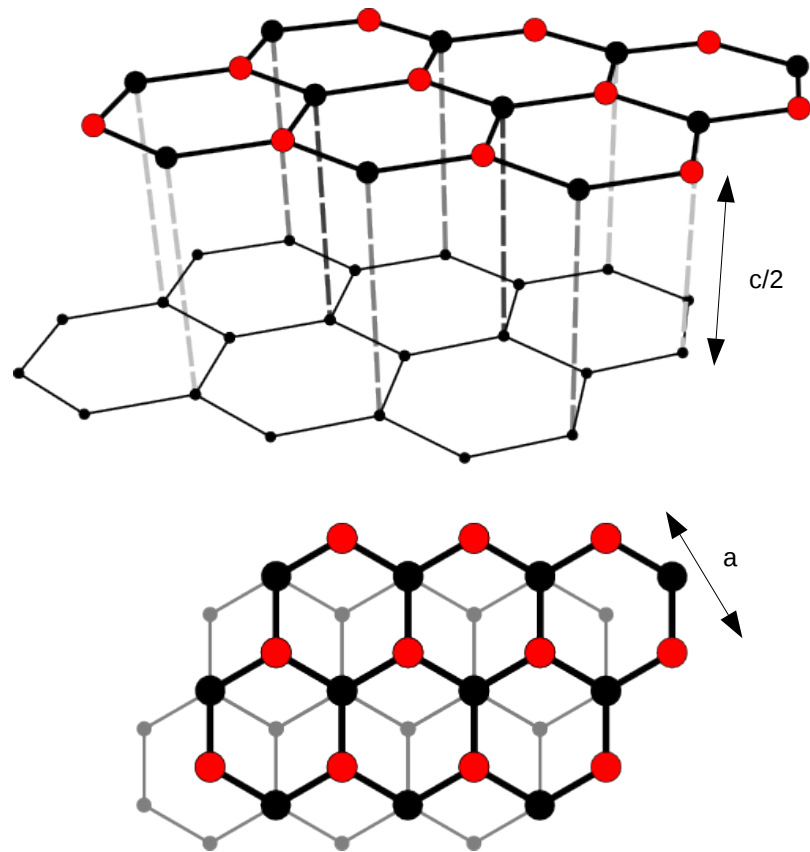


Abbildung 2: Schematische Struktur von Graphit. Die Ebenen liegen im ABAB-Form vor, sodass immer die jede zweite gleich aufliegt. Die Ebenen untereinander besitzen nur an jedem zweiten Punkt der Hexagonale eine Verbindung. Entnommen von [3], modifiziert

Die in Abbildung 2 eingezeichneten Gitterkonstanten haben die Werte $a = 2.26 \text{ \AA}$ und $c = 6.71 \text{ \AA}$ (vgl. [4]). Aufgrund ABAB-Form liegen immer drei Atome in den Hexagonalen etwas erhöht und haben so eine höhere freie elektrische Zustandsdichte. Diese Struktur ist mit dem RTM zu sehen.

2.3.2 Gold

Gold hat eine fcc-Kristallstruktur, dabei beträgt die Gitterkonstante $a = 4.065 \text{ \AA}$ [1]. Untersucht wird die (111)-Goldschicht, wobei (111) die Millerindizes sind, die die räumliche Struktur des Kristalls beschreiben. Die atomare Struktur von Gold ist deutlich schwerer zu messen, da die Atome homogen verteilt sind.

3 Versuchsaufbau

In diesem Abschnitt wird der Aufbau des Rastertunnelmikroskops beschrieben. Das Rastertunnelmikroskop basiert auf dem in Abschnitt 2.1 beschriebenen Tunneleffekt. Die leitende Spitze

des Rastertunnelmikroskops wird hinreichend nah an die Oberfläche des zu untersuchenden Material geführt, berührt diese jedoch nicht. Wird eine Spannung angelegt, so kann ein “Tunnelstrom” fließen. Bewegt man nun die Spitze parallel zur Oberfläche, so erhält über den Tunnelstroms ort aufgelöste Informationen über die Oberfläche.

Grundlegend ist das Rastertunnelmikroskop aus drei Elementen aufgebaut, einem Tastkopf, einem Piezosteurelement und einer Probe. Der Tastkopf besteht aus einem Draht, mit einer Spitze, die möglichst einatomig sein soll. Durch die Dicke der Spitze wird das Auflösungsvermögen des Mikroskops festgelegt. In diesem Versuch wird ein Platin-Iridium-Draht als Tastkopf verwendet. Das Piezosteurelement dient zur Positionierung der Spitze. Dabei kann der Tastkopf im nm-Bereich verschoben werden. Für die Untersuchung einer Oberfläche mit einem Rastertunnelmikroskop muss die Probe bestimmte Eigenschaften erfüllen. Die Probe muss ein Leiter oder ein Halbleiter sein. Das beschichten der Oberfläche mit einem leitendem Material ist nicht möglich, da die Oberflächenstruktur durch die Beschichtung verdeckt wird.

Ein schematischer Versuchsaufbau ist in Abbildung 3 zu sehen.

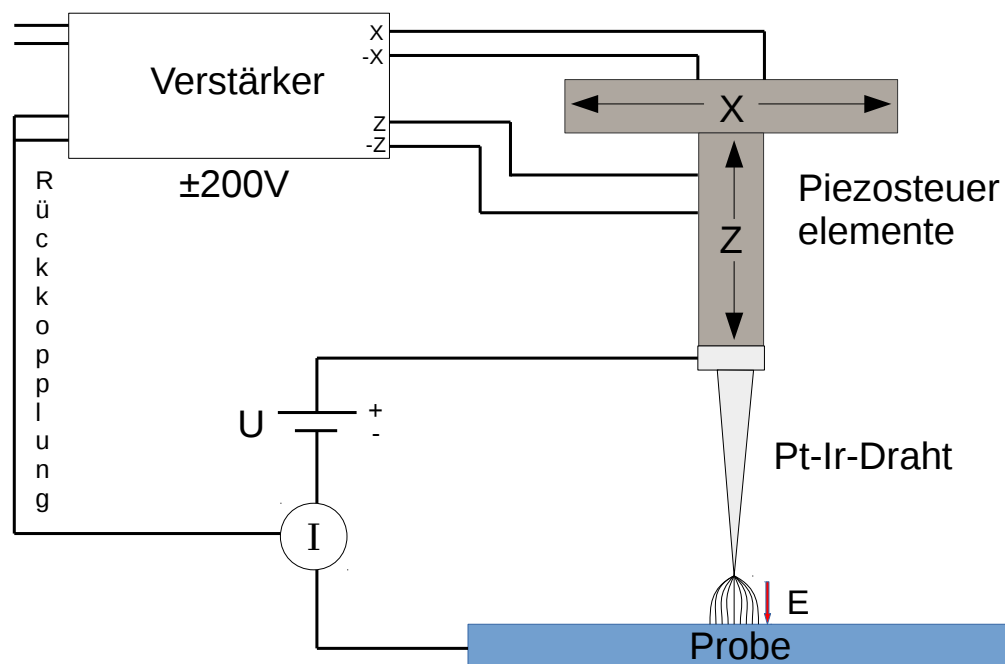


Abbildung 3: Schematische Skizze des Versuchsaufbaus. Die Positionierung der Platin-Iridium-Tastkopfes wird über die Piezoelemente im nm-Bereich gesteuert. Die Rückkopplung dient zur Steuerung der Höhe des Tastkopfes.

Da eine Spannung angelegt wird, sind die Fermi-Energien der beiden Materialien nicht mehr auf dem selben Niveau. Ist der Abstand zwischen der Spitze und dem Material hinreichend klein, so kann die Potenzialbarriere durchtunnelt werden und es fließt ein Tunnelstrom. Der Tunnelstrom wird durch den Verstärker in eine Spannung umgewandelt und kann so gemessen werden. Dabei ist die Spannung proportional zum Tunnelstrom, welcher in Abhängigkeit des Abstandes zwischen der Spitze und der Probe mit Gleichung 3 bestimmt werden kann. Die Feldstärke E , des E-Feldes zwischen der Spitze und der Probe kann mit $E = \frac{U}{d}$ bestimmt werden. Die

Stromdichte j erhält man durch $j = \frac{I}{A}$. Für die Oberfläche der Spitze wird angenommen, dass sie aus nur einem Atom besteht. Die Oberfläche lässt sich mit $A = \pi \cdot R_{Atom}^2$ bestimmt. Für den Radius wurde ein Wert von 1.35 \AA [5] angenommen, es ergibt sich eine Oberfläche von 5.73 \AA^2 . Die Parameter und die erwarteten Werte sind in Tabelle 1 beschrieben.

Tabelle 1: Parameter mit Erwartungswerten für die Graphit und Gold.

Parameter	Gold	Graphit
tip voltage U	50mV	500mV
unnelstrom U	1nA	1nA
Feldstärke E	50kV/mm	500kV/mm
Stromdichte j	17,5kA/mm ²	17,5kA/mm ²

Anhand der Werte in Tabelle 1 kann man sehen, dass die Feldstärke und die Stromdichte sehr große Werte annehmen, dies liegt an der geringen räumlichen Ausdehnung.

3.1 Betriebsmodi

Das Rastertunnelmikroskop kann in zwei Modi betrieben werden, Constant Current Mode (“Topographie”) und Constant Hight Mode (“Elektronendichte”).

3.1.1 Constant Current Mode

Im Constant Current Mode wird der Abstand zwischen der Probe und dem Tastkopf konstant gehalten. Dafür wird ein über ein PID-Regler der Abstand so geregelt, dass der Tunnelstrom konstant bleibt. Die Information über die Oberflächenstruktur kann aus der Veränderung der z-Position entnommen werden. Ein schematische Skizze der Funktionsweise ist in Abbildung ?? zu sehen.

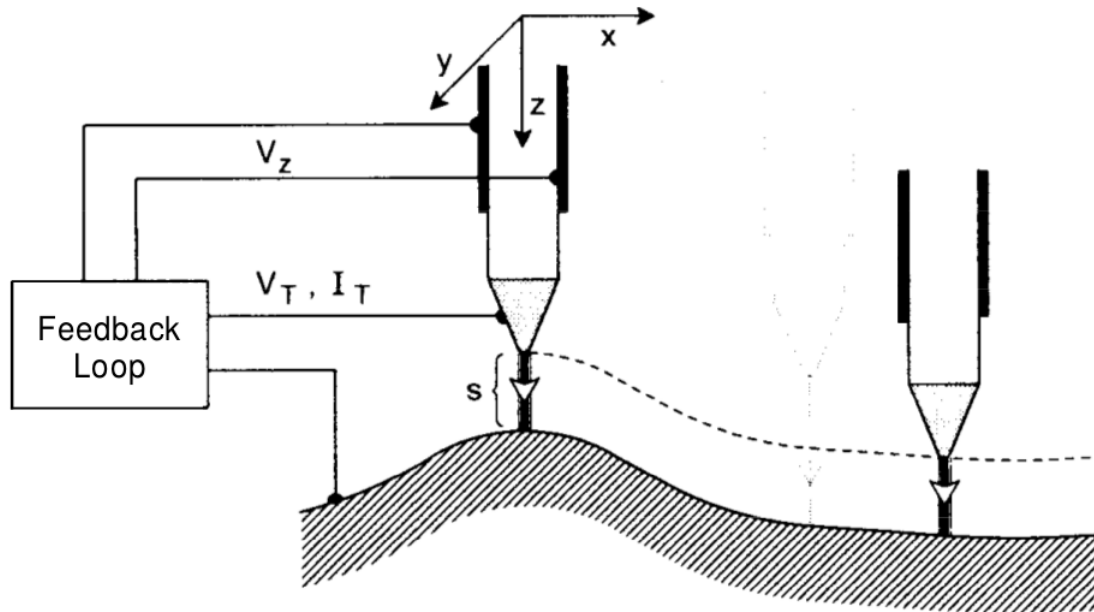


Abbildung 4: Darstellung des Constant Current Mode für das Rastertunnelmikroskop. Entnommen von [2]

3.1.2 Constant Hight Mode

Im Constant Hight Mode wird der Abstand zwischen Probe und Tastkopf einmal eingestellt und nicht mehr verändert. Bei Unebenheiten in der Oberfläche kann es jedoch zu Kollisionen kommen, wodurch der Tastkopf zerstört werden kann. Der Vorteil der Messmethode ist, dass der gemessenen Tunnelstrom proportional zur Elektronendichte bei der Fermi-Energie ist.

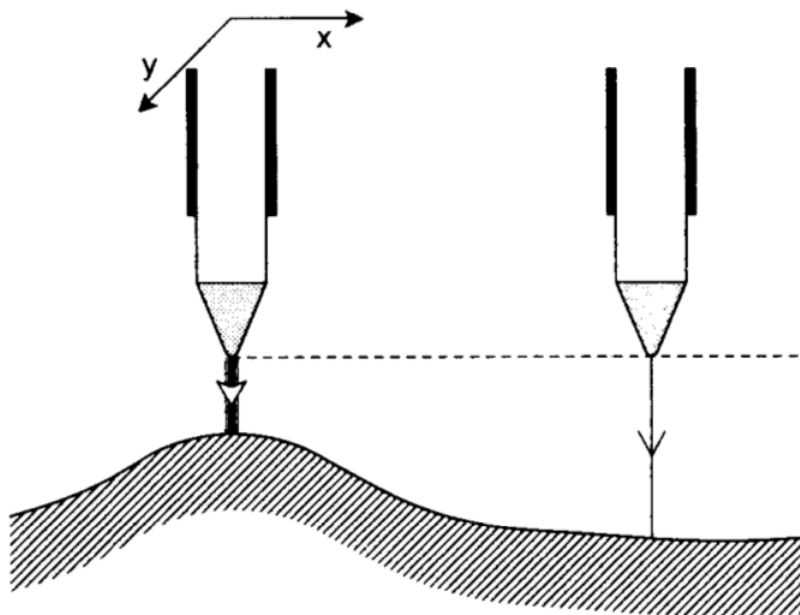


Abbildung 5: Darstellung des Constant Hight Mode für das Rastertunnelmikroskop. Entnommen von [2]

4 Versuchsdurchführung und Auswertung

Die mittlere Flächen- bzw. Linien-Rauheit (CC-Mode), die Gitterstruktur, die Atomabstände und im glatten Bereich die Elektronendichteverteilung von [HOPG]-Graphit (CH-Mode) soll aus den mit dem RTM gemessenen Daten bestimmt werden. Danach soll die Flächen- und Linien-Rauheit, monoatomare Stufen, Gitterfehler und Stufenhöhen, sowie Gitterparameter einer (111)-Goldschicht (CC-Mode) erfasst werden.

4.1 Graphit

Die Graphitschicht konnte magnetisch auf der Probenhalterung angebracht werden. Die Vorbereitungen für die Graphitmessung dauerten nicht lange, da nach wenigen Versuchen eine funktionsfähige Pt-Ir-Spitze angefertigt werden konnte. Für die Anfertigung der Pt-Ir-Spitze standen Isopropanol, Reinigungstücher, eine Pinzette und eine Zange zu halten des Drahtes. Um den Pt-Ir-Draht anzuspitzen, stand uns ein Seitenschneider zur Verfügung, mit dem der Draht angeschnitten wurde, sodass durch darauffolgendes kräftiges Ziehen eine (idealerweise) einatomige Spitze erzeugt werden konnte. Nachdem eine passende Pt-Ir-Spitze hergestellt werden konnte, wurde mit dem RTM ein Bereich von 600nm im „Topographie“-Modus (CC) abgerastert. Die dazu benötigten Einstellungen konnten mit dem Programm für das RTM eingestellt werden und sind in Tabelle 2 dargestellt.

Tabelle 2: Parameter zur Topographiemessung (CC-Mode)

Variable	Wert
Set point	1 nA
P-gain	1000
I-gain	1700
Tip-voltage	50 mV

Die Topographiemessung über 600 nm ist in Abbildung 6 dargestellt.

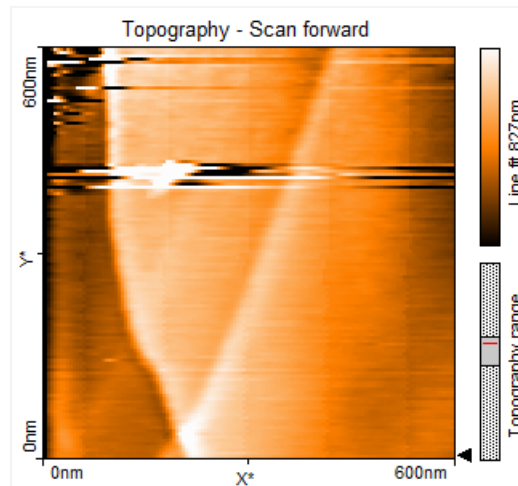


Abbildung 6: 600 nm Bild im Topographie/CC-Modus

4.1.1 Rauheit

Die Rauheit der Graphitschicht konnte mit der Software für das RTM bestimmt werden, nachdem die Graphitschicht im CC-Modus mit der Spitze des RTM abgerastert wurde. Die Verkipung wurde bestimmt und grob bis auf 0.2° korrigiert. Das Fenster Topography-Scan ist für die Messung nicht wichtig, da es die Oberflächenbeschaffenheit ausschließlich auf Höhe des schwarzen Pfeils angibt. In Abbildung 7 ist die Messung zur Bestimmung der mittleren Linienrauheit dargestellt.

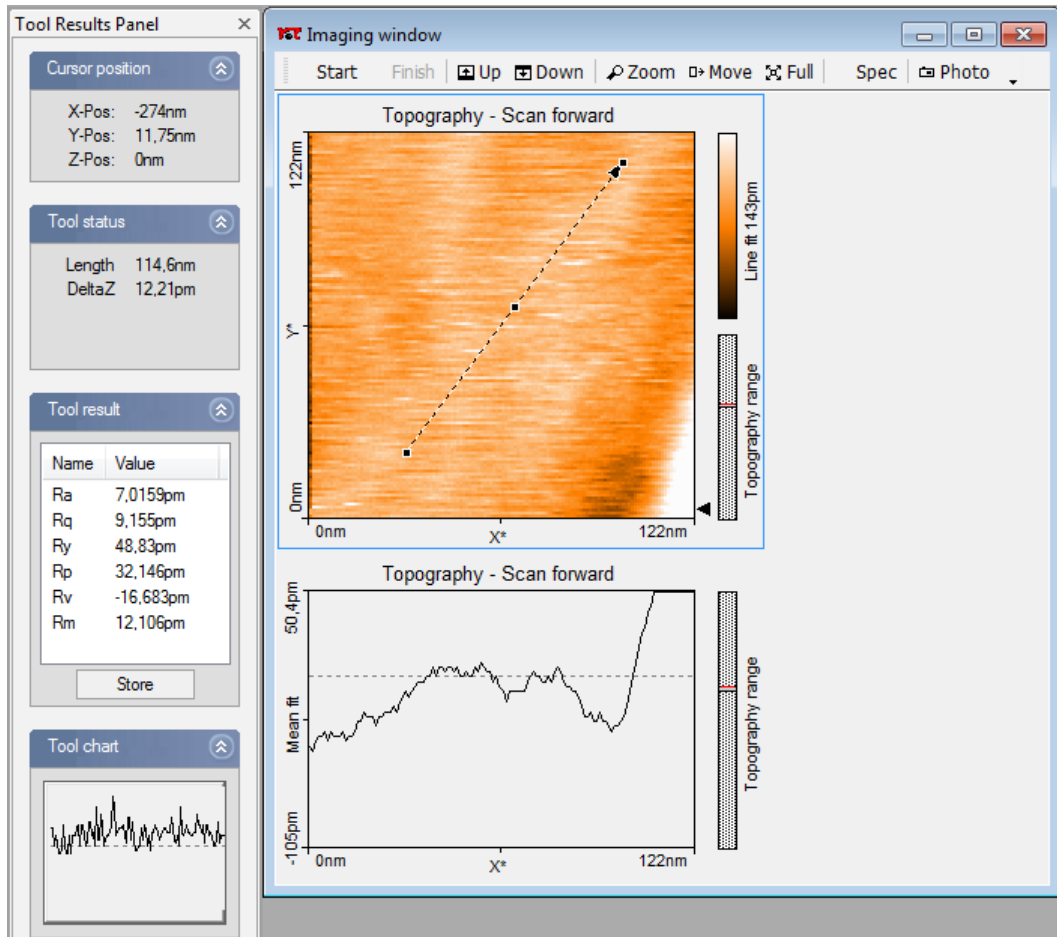


Abbildung 7: Mittlere Linienrauheit von Graphit entlang der abgebildeten Linie ($R_a = 7.0159 \text{ pm}$ und $R_q = 9.1550 \text{ pm}$)

Ebenso wurde die mittlere Flächenrauheit der Graphitprobe bestimmt, welche in Abbildung 8 dargestellt ist.

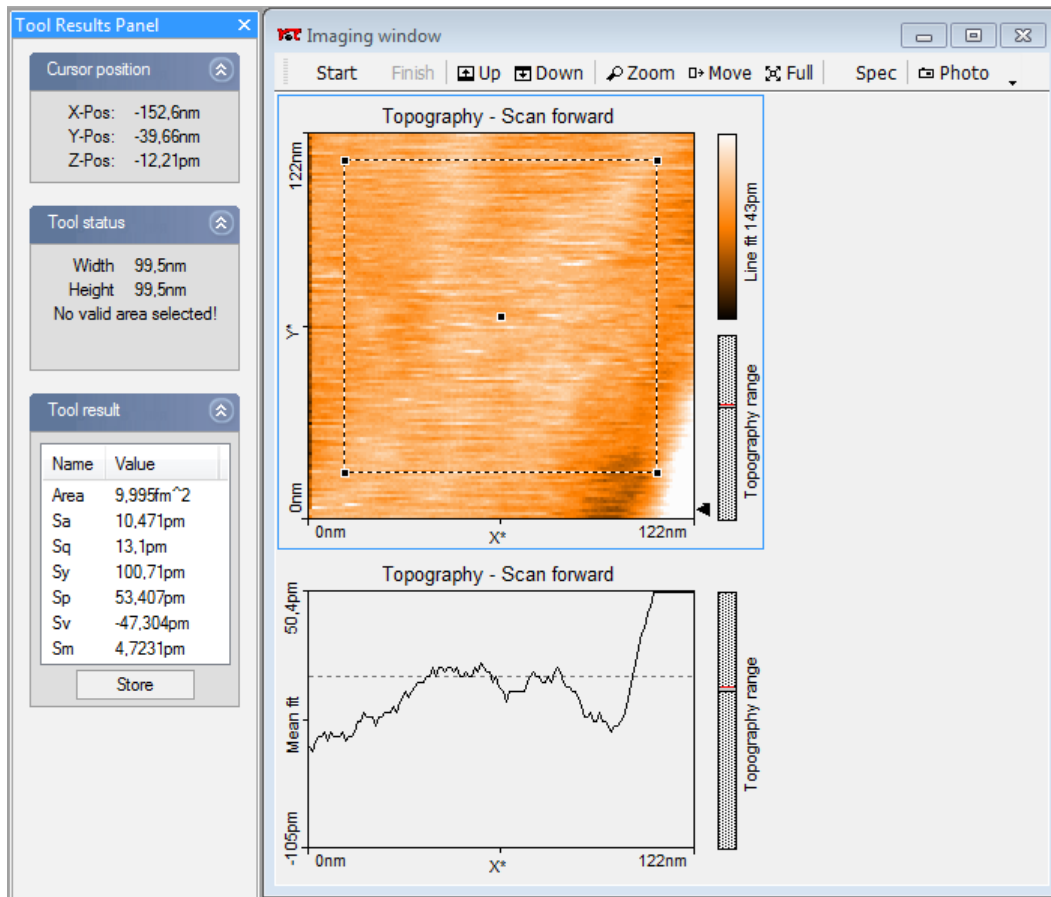
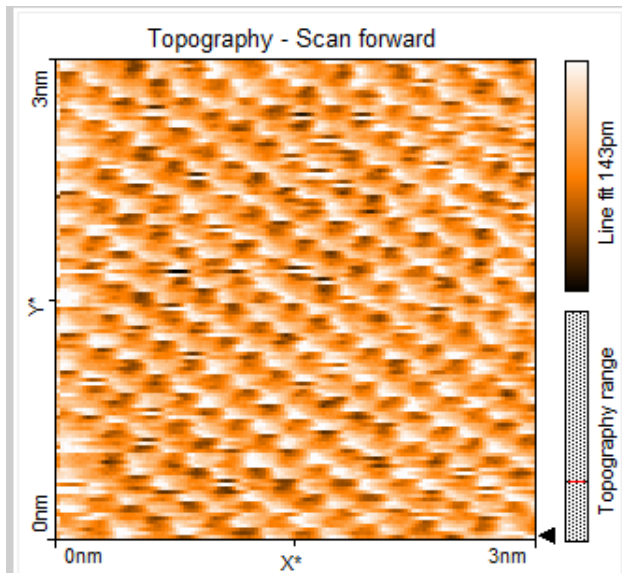


Abbildung 8: Mittlere Flächenrauheit von Graphit für die Fläche im Quadrat ($S_a = 10.471$ pm und $S_q = 13.100$ pm)

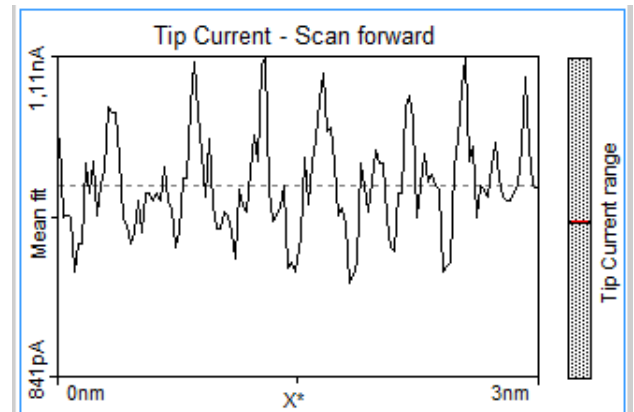
Man sieht, dass die mittlere Flächenrauheit größer als die mittlere Linienrauheit ist, wobei der Anteil der arithmetischen Rauheit an der quadratischen Rauheit bei beiden Messungen in etwa gleich groß ist ($\frac{R_a}{R_q} = 0,78 = 78\%$ und $\frac{S_a}{S_q} = 0,80 = 80\%$). Für die Linienrauheit wurde eine möglichst glatte Linie gewählt, wodurch der Unterschied zur quadratischen Rauheit begründet werden kann. Insgesamt fällt auf, dass die Oberflächenrauheit von HOP-Graphit relativ gering ist. Die Ähnlichkeit von Linienrauheit und Flächenrauheit sprechen bei dieser Oberfläche für eine gute Messung und eine glatte Graphitoberfläche, deren Rauheit ohne thermische Schwingungen wahrscheinlich noch geringer wäre. Gitterdefekte hatten dabei geringen Einfluss auf die Messung.

4.1.2 Gitterstruktur und Elektronendichteverteilung

In diesem Abschnitt soll die Elektronendichteverteilung und die Gitterstruktur des Graphit untersucht werden. Dafür wurde ein kleiner Bereich herangezoomt, damit die atomare Struktur sichtbar wird. Es wurde ein Bereich von 3×3 nm verwendet, der möglichst glatt erscheint. Die Verkipfung der Probe wurde korrigiert, die Aufnahme ist in Abbildung 9 zu sehen.



(a) Oberfläche der Graphitprobe bei atomarer Auflösung. Es lässt sich die hexagonale atomstruktur erkennen.



(b) Beispielhafter topologischer Verlauf, entlang der x-Achse

Abbildung 9: Aufnahme der Oberflächen von Graphit in einem Bereich von 3 x 3 nm. Die Höhendifferenz liegt im Bereich von 1,5 Å

Um die Gitterstruktur noch besser sehen zu können, wird die Oberfläche noch im Constant Hight Mode gescant. Dafür werden der P_{gain} auf 0V und der I_{gain} auf 4V eingestellt. Für den Scan wurde eine Fläche von 1,1 x 1,1 nm gewählt. Die Aufnahme, mit eingezeichneter hexagonaler Struktur ist in Abbildung 10 zu sehen. Die Aufnahme wurde geschert, damit die Gitterstruktur besser zu erkennen ist.

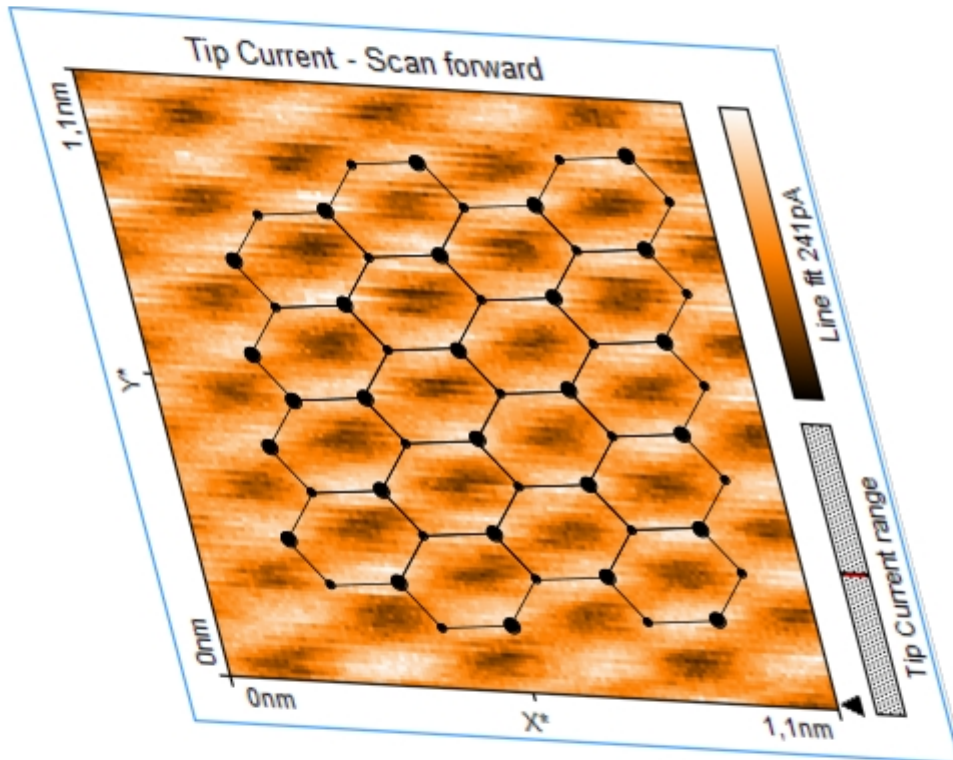


Abbildung 10: Aufnahme der Oberfläche im Bereich von 1 x 1 nm. Zur Veranschaulichung wurde die Gitterstruktur eingezeichnet.

Abbildung 10 ist so zu interpretieren, dass an den hellen Stellen die Gitteratome ohne Verbindungen zur darunterliegenden Schicht liegen, daher liegen die Elektronen direkt am Atom an und es wird ein höherer Tunnelstrom gemessen. An den orangen Stellen befinden sich die Atome mit einer Verbindung zur darunterliegenden Schicht, wodurch der Tunnelstrom geringer wird. Die schwarzen Bereiche entsprechen der Mitte der Hexagons, bei welchen das nächste Atom erst in der darunterliegenden Schicht liegt, sodass der Tunnelstrom sehr gering ist.

4.1.3 Mittlerer Atomabstand

Der mittlere Atomabstand wird aus den Messdaten mithilfe eines Bildbearbeitungsprogramms bestimmt. Die Abbildung ist durch die Messung verzerrt, da die Piezoelemente nicht in allen Richtungen die gleiche Kalibrierung haben. Man erkennt dies insbesondere an den Winkeln zwischen den eingezeichneten Linien, welche nicht wie erwartet durch die sp^2 -Hybridorbitale von [HOP]-Graphit und der dadurch resultierenden Hexagonalstruktur 60° betragen. Die Winkel zwischen den eingezeichneten Linien betragen $\alpha = \angle(B, C) = 59.99(1)^\circ$, $\beta = \angle(A, C) = 72.33(1)^\circ$ und $\gamma = \angle(A, B) = 47.68(1)^\circ$. Insgesamt kann dadurch eine Abweichung vom wirklichen Atomabstand entstanden sein.

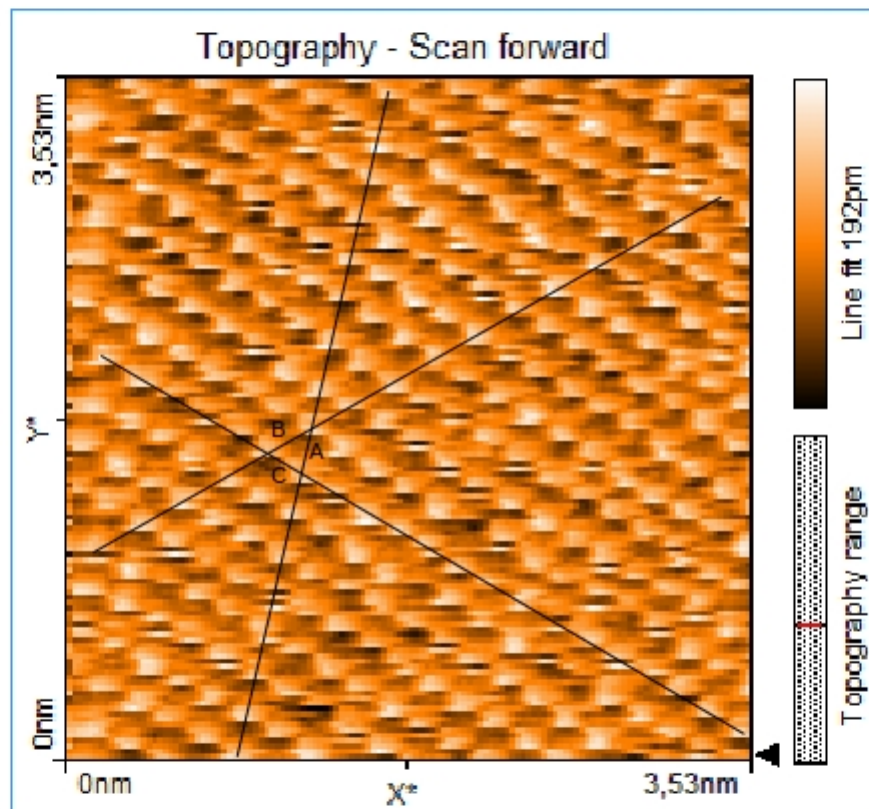


Abbildung 11: Bestimmung des mittleren Atomabstandes

Um den Atomabstand aus Abbildung 11 zu bestimmen, werden die Längen von Linien parallel zu den eingezeichneten Linien gemessen und durch die Anzahl der Verbindungen von hellen Stellen geteilt. In Tabelle 3 sind die Messwerte für alle drei Richtungen eingetragen.

Tabelle 3: Atomabstände der Graphitprobe. Der Fehler auf die Länge der Linien beträgt an jedem Ende ein Drittel der Atomgröße, sodass der Gesamtfehler auf die Länge der Linie zwei Drittel der Atomgröße $\cong 73.8 \text{ pm}$ beträgt. In der Tabelle ist die Länge der Linie, die Anzahl der Atomabstände und der daraus resultierende Atomabstand mit Fehler auf der letzten Stelle eingetragen.

Parallel zu	Gesamtlänge L/nm	n	Atomabstand a/pm
A	3,53	16	221(5)
	3,29	15	220(5)
	3,49	16	218(5)
	3,33	15	222(5)
B	3,73	15	249(5)
	3,75	15	250(5)
	4,00	16	250(5)
	3,71	15	248(5)
C	3,86	20	193(4)
	4,00	21	190(4)
	3,89	20	195(4)
	3,86	20	193(4)

Der Mittelwert der Atomabstände 'A' beträgt $\overline{a_A} = 220 \text{ pm}$, mit einem Gaußfehler von 2.5 pm und einem statistischen Fehler von 0.9 pm . Der Mittelwert der Atomabstände 'B' beträgt $\overline{a_B} = 249 \text{ pm}$, mit einem Gaußfehler von 2.5 pm und einem statistischen Fehler von 0.6 pm . Der Mittelwert der Atomabstände 'C' beträgt $\overline{a_C} = 193 \text{ pm}$, mit einem Gaußfehler von 2 pm und einem statistischen Fehler von 1 pm . Man sieht, dass der statistische Fehler unterdem Gaußfehler liegt, sodass die Atommitte anscheinend besser abgeschätzt werden konnte als vermutet. Die Abweichung vom Literaturwert von 246 pm ist bei allen Mittelwerten verschieden groß. Insgesamt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel über alle Werte ein Atomabstand von $\bar{a} = 221(1) \text{ pm}$, welcher vom Literaturwert um 10% nach unten abweicht. Wahrscheinlich ist diese Abweichung zum Großteil durch die Einstellung der Piezoelemente entstanden. Der Atomabstand d_{Atom} zum nächsten Nachbaratom kann aus dem Cosinussatz gewonnen werden.

$$a^2 = 2d_{Atom}^2(1 - \cos(120^\circ)) \quad (8)$$

$$d_{Atom} = \frac{a}{\sqrt{3}} \quad (9)$$

Es ergibt sich ein mittlerer Atomabstand von $d_{Atom} = 127.4(8) \text{ pm}$, welcher vom Literaturwert 142 pm nach wie vor um ca. 10% nach unten abweicht. Da die Abstände in verschiedenen Richtungen wie bereits erwähnt systematisch voneinander abweichen, wäre es möglich Korrekturen mittels einer Scherung und Streckung im $\mathbb{R}^2 = \langle \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2 \rangle$ durch die Matrix

$$M_{scher, streck} = \begin{pmatrix} 1 & a/b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & b \end{pmatrix} \quad (10)$$

mit dem Scherfaktor a/b (in Richtung \mathbf{e}_1) und dem Streckfaktor b (in Richtung \mathbf{e}_2) in Abbildung 11 herbeizuführen. Falls man nun die Längenmaße mittransformiert, wird sich an den Messwerten nichts ändern. Deshalb kann eine Korrektur ausschließlich durch die Benutzung der alten Längenmaße für das gescherstreckte Bild herbeigeführt werden. Allerdings müsste man sich für eine Richtung \mathbf{e}_1 entscheiden, deren Länge bei der Scherstreckung konstant bleibt. Die 'Atomabstände' in dieser Richtung erzeugen damit den neuen mittleren Atomabstand, sodass je nachdem, wie man \mathbf{e}_1 wählt, das gewünschte Ergebnis für den mittleren Atomabstand erzielt werden kann. Da die Richtung von \mathbf{e}_1 nur geraten werden kann, kann der Fehler durch die Verzerrung aus den Messwerten nicht zurückverfolgt werden. Der Fehler bleibt also als systematischer Fehler bestehen, wobei man die Messdaten durch geeignete Wahl von \mathbf{e}_1 perfekt manipulieren könnte, da sowohl Werte unter dem Literaturwert, als auch Werte über dem Literaturwert gemessen wurden. Damit kann die Abweichung von 10 % zum Großteil durch systematische Fehler erklärt werden.

4.2 (111)-Goldschicht

Die Rauheit der Goldschicht sollte mit dem RTM bestimmt werden. Dazu wurde die Oberfläche der Goldschicht mit dem RTM im CC-Mode abgerastert. Wegen der Kornstruktur wurden für die Bestimmung der Flächenrauheit zwei Messungen vorgenommen, sodass Korngrenzen nur in der ersten Messung in die Berechnung der Rauheit eingingen. Die (111)-Goldschicht musste aufgrund von Kratzern auf der Oberfläche mehrfach gedreht werden. Während der Justierung ist die Pt-Ir-Spitze des RTM mit der Oberfläche der Goldschicht kollidiert, sodass eine zweite Pt-Ir-Spitze angefertigt werden musste. Diese konnte ebenfalls nach wenigen Versuchen aus bereits benutzten Pt-Ir-Spitzen angefertigt werden. Zu erste wird eine Aufnahme mit maximalem Scanbereich gemacht, dabei wird die tip-Voltage von 50mV auf 500mV erhöht, um ein schärferes Bild zu erhalten. In Abbildung 12 ist die Aufnahme mit maximalem Scanbereich zu sehen.

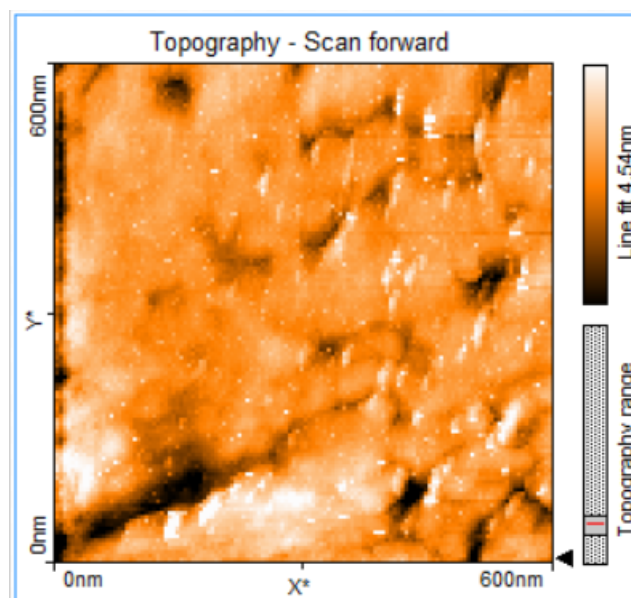


Abbildung 12: Aufnahme der Gold(111)-Schicht mit einer tip-Voltage von 500mV. Im rechten Bereich der Abbildung ist die Kornstruktur der Probe gut zu erkennen.

In Abbildung 12 ist vor allem im rechten Bereich die Kornstruktur des Goldes zu sehen. Für die Aufnahme wurden die Verkipfungen bereits korrigiert.

4.2.1 Rauheit

Für die Untersuchung der Oberflächen- und Linien Rauheit wurde ein Bereich von 202nm ausgewählt. Da ein möglichst glatter Bereich gewählt werden sollte, wurde der obere linke Bereich in aus Abbildung 12 ausgewählt. In Abbildung 13 ist eine Aufnahme des Bereichs zu sehen.

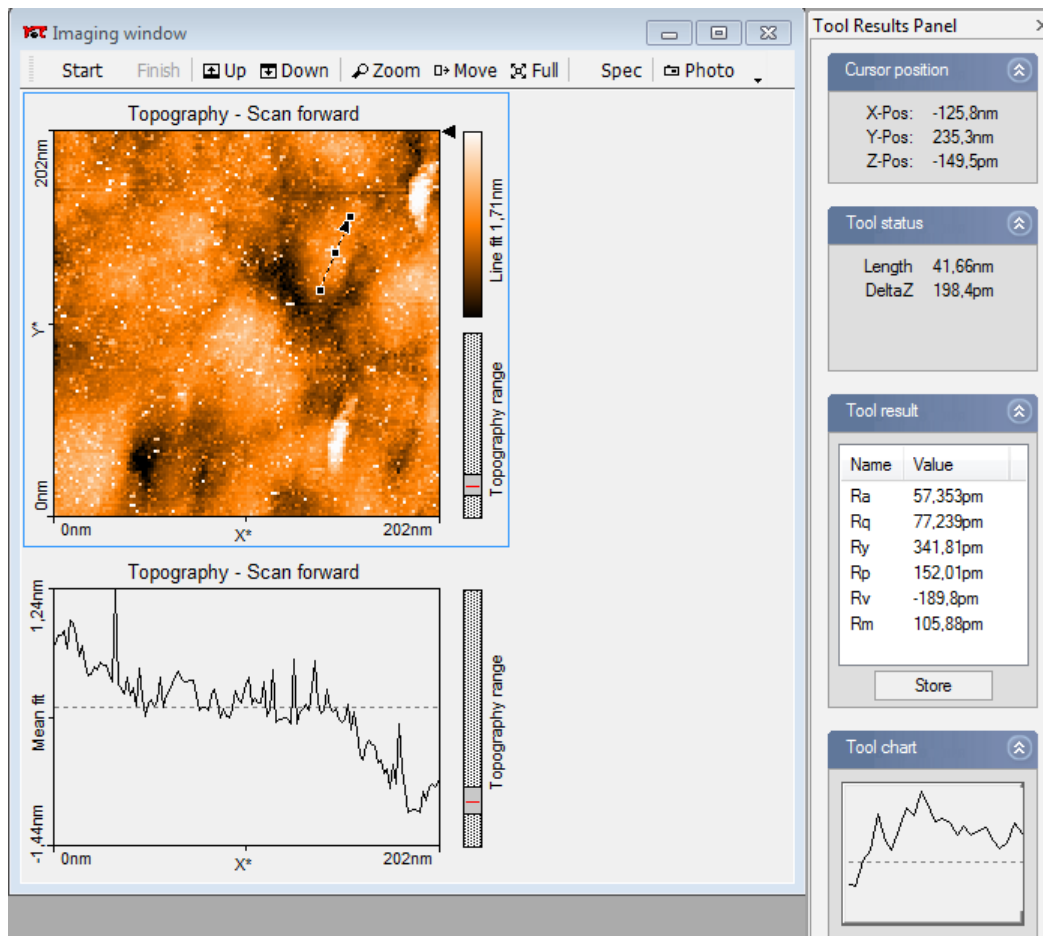
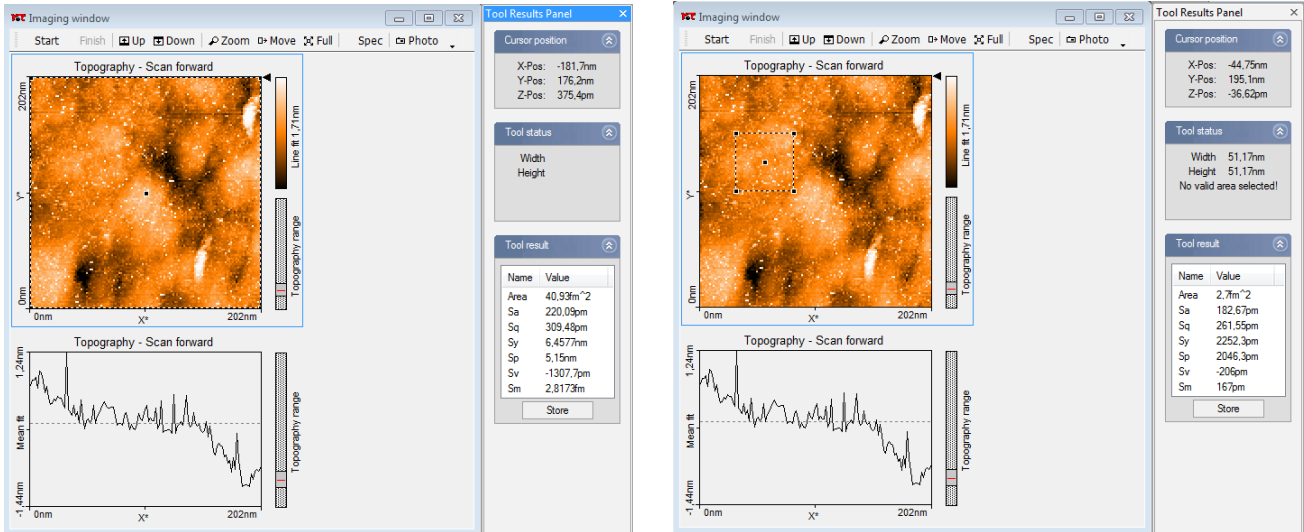


Abbildung 13: Mittlere Linienrauheit der (111)-Goldschicht ($R_a = 57.353 \text{ pm}$ und $R_q = 77.239 \text{ pm}$)



(a) Mittelung über die gesamte Fläche, da durch die Kornstruktur keine große glatte Fläche zu finden war. ($S_a = 220.09$ pm und $S_q = 309.48$ pm)

(b) Mittelung eine kleinere möglichst glatte Fläche. Die Verkipfung wurde bei allen Messungen korrigiert. ($S_a = 182.67$ pm und $S_q = 261.55$ pm)

Abbildung 14: Mittlere Flächenrauheit der (111)-Goldschicht

Die Oberflächenrauheit wird für die gesamte Oberfläche und für die glatte Oberfläche oben links bestimmt (vgl. Abbildung 14b). Bei der Bestimmung der Oberflächenrauheit, wurden die Werte in Tabelle 4 bestimmt, dafür wurde die Funktion von easy2Scan verwendet.

Tabelle 4: Flächenrauheit der Goldprobe für die gesamter Flächen und die Ausschnitt in Abbildung 14b

Lokalisation	S_a	S_q
Gesamter Bereich	220,09pm	309,48pm
Bereich von Abbildung 14b	182,67pm	261,55pm

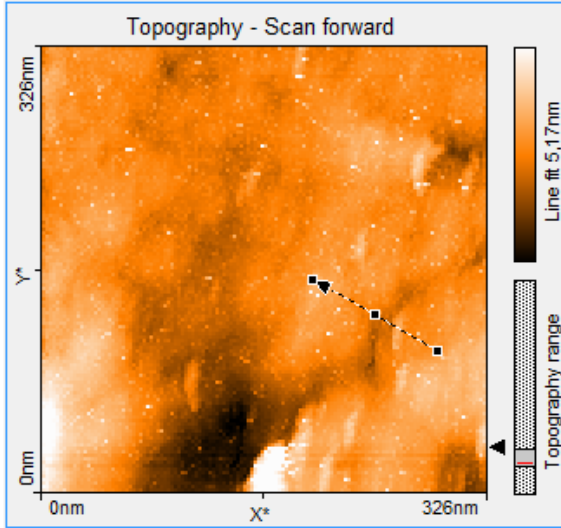
Die bestimmten Werte zeigen das an der glatten Stelle die Oberflächenrauheit mit S_a 182,67pm um 20% geringer als auf der gesamten Fläche ist. Die Oberflächenrauheit auf der gesamten Flächen beträgt $S_a = 220,09$ pm. Die Aufnahme der Linienrauheit ist in Abbildung 13 zu sehen. Es wurde eine Linienrauheit von $R_a = 57,353$ pm bestimmt, die quadratische Linienuhheit liegt bei $R_q = 77,239$ pm. Die bestimmte Flächenrauheit ist ca. 3 mal größer als die bestimmte Linienrauheit. Dieses Resultat deutet auf die unregelmäßige Kornstruktur von Gold hin, welche die Flächenrauheit einer Fläche von ca. 2700 nm² beeinflusst.

4.2.2 Monoatomare Stufen und Gitterdefekte

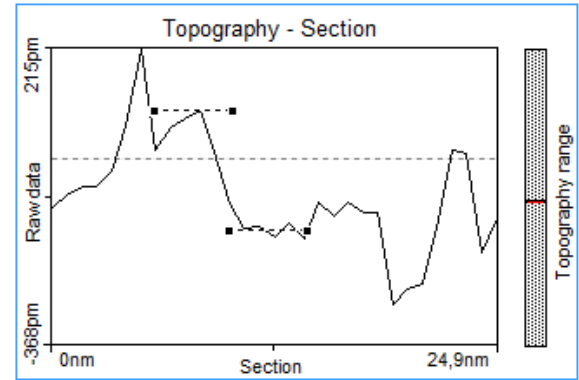
In diesem Abschnitt soll die atomare Struktur der Goldprobe untersucht werden. Da Gold eine homogene Elektronendichteverteilung hat, kann man die Struktur nicht wie beim Graphit bestimmen. Für die Bestimmung dieser, werden monoatomare Stufen gesucht. Diese Stufen entsprechen dem Netzebenenabstand der Gold(111)-Probe. Da Gold eine fcc-Struktur besitzt, kann mit Gleichung 11 und einer Gitterkonstante von $a=4.08$ Å der atomare Abstand bestimmt werden.

$$d_{111} = \frac{a}{\sqrt{3}} = 236\text{pm} \quad (11)$$

Da nicht hinreichend monoatomare Stufen gefunden wurden, wurden Stufen höherer Ordnung hinzugenommen. Beispielhaft ist eine Stufe in Abbildung 15 zu sehen. Alle weiteren Aufnahmen sind im Anhang zu finden.



(a) Abschnitt, auf dem die Stufe aufgenommen wurde



(b) Topographischer Verlauf entlang des gewählten Weges. Die Höhe der Stufe beträgt 238 ± 12 pm

Abbildung 15: Beispielhafte Darstellung einer mono atomaren Stufe

Um ein gutes Ergebnis zu erhalten, wurden mehrere Messungen gemacht. Da nicht genügend einatomige Stufen vorhanden waren, wurden Stufen höherer Ordnungen hinzugenommen. Dabei wurde die Ordnung der Stufe jeweils geschätzt. Die Fehler wurden je nach Rauschen mit 5% bis 10% abgeschätzt. Die gemessenen Werte sind in Tabelle 5 zu sehen.

Tabelle 5: Gemessene Stufen für die Bestimmung des Netzebenenabstandes der Goldprobe. Die Fehler wurden dabei mit 5% bis 10% abgeschätzt. n gibt die Ordnung der Stufe an, diese wurden jeweils geschätzt

Stufenhöhe/pm	n	Netzebeneabstand/pm
236 ± 12	1	236 ± 12
236 ± 12	1	236 ± 12
243 ± 12	1	243 ± 12
234 ± 12	1	234 ± 12
238 ± 12	1	238 ± 12
959 ± 48	4	239 ± 12
714 ± 36	3	238 ± 12
935 ± 47	4	234 ± 12

Aus den Messdaten ergibt sich ein Mittelwert von $\bar{d}=(237\pm)4\text{pm}$ dieser Weicht relativ um 0,42% vom Erwartungswert 236pm ab. Das Ergebnis entspricht einer guten Messung. Es sei jedoch gesagt, dass speziell nach "guten" Kanten gesucht wurde, wodurch nicht sichergestellt ist, dass der bestimmte Wert die Gesamtheit der Kanten repräsentiert. Durch das aussuchen der Kanten wurde jedoch verhindert, dass Kanten, die von Gitterschäden kommen ausgewertet wurden. In Abbildung 16 ist auf der rechten Seite eventuell ein Gitterdefekt zu sehen.

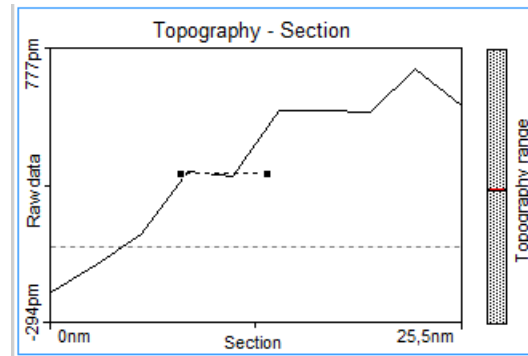


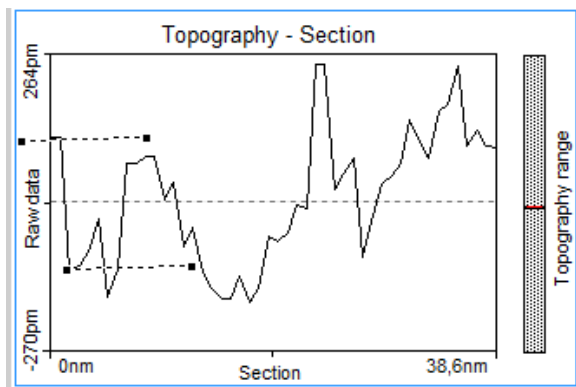
Abbildung 16: Der Peak an der rechten Seite könnte ein Gitterdefekt sein, seine Höhe entspricht ca. dem halbem Netzebenenabstand von Gold.

4.3 Diskussion

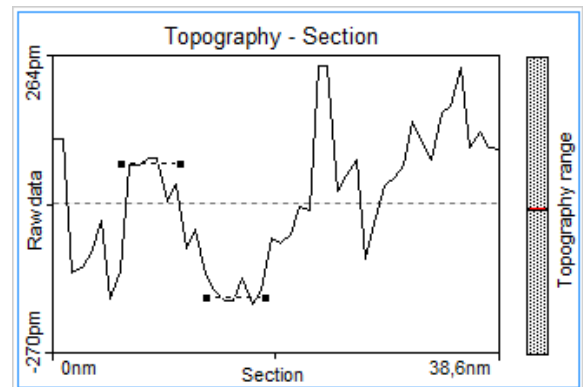
5 Fazit

Im Versuch wurden Graphit und Gold(111) mittels eines Rastertunnelmikroskops untersucht. Es wurden die Oberflächen- und Linienrauheit, sowie die Gitterstruktur der Proben untersucht. Zu erst wurde die Graphitprobe untersucht, dabei wurde die Oberflächenrauheit S_a mit 10,471pm bestimmt, die Linienrauheit R_a wurde mit 7,016pm bestimmt. Bei der Untersuchung der Gitterstruktur konnte die Hexagonalestrktur deutlich gezeigt werden (vgl. Abbildung 10). Die Gitterkonstanten wurde mit ?? bestimmt. Bei der Untersuchung der Goldprobe wurde die Oberflächenrauheit S_a für einen Bereich von 202 x 202 nm mit 220,09 pm bestimmt. Die Lini- enrauheit wurde mit 57,353pm bestimmt. Der Netzebenenabstand der Gold(111)-Probe wurde mit 237(4)nm bestimmt, dies entspricht einer relativen Abweichung von 0,42%.

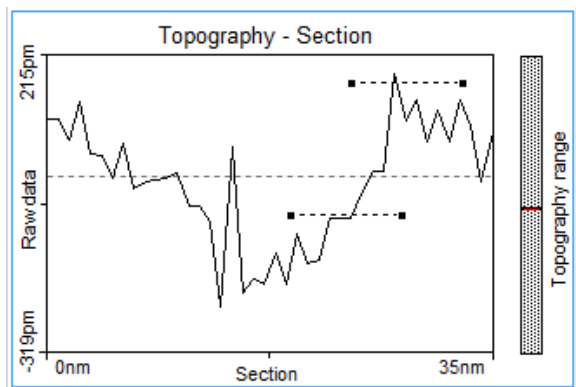
6 Anhang



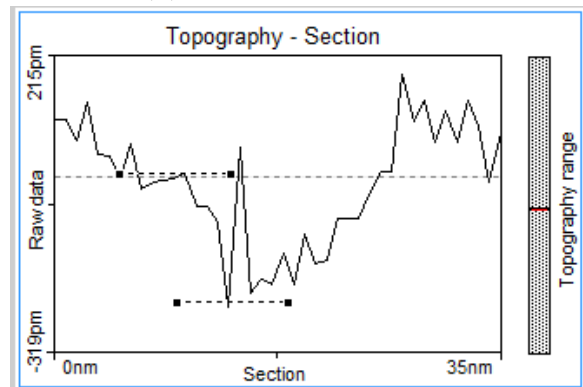
(a) Stufenhöhe 236 ± 12



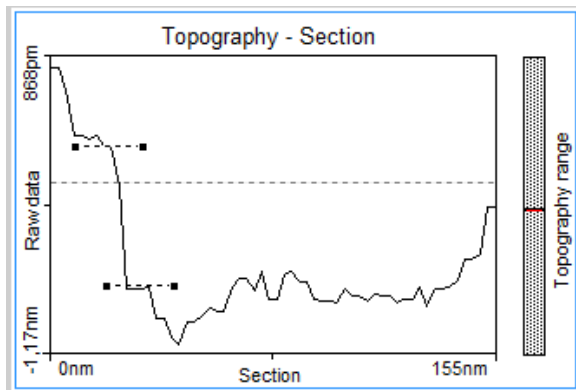
(b) Stufenhöhe 236 ± 12



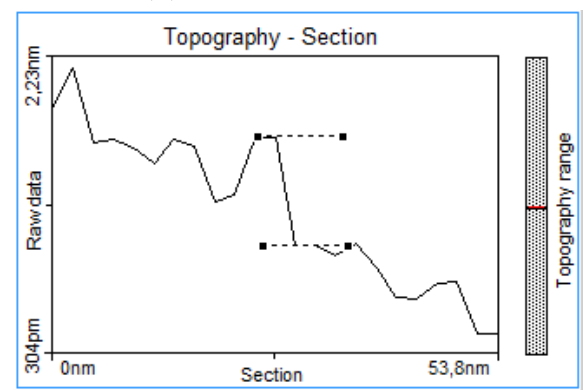
(c) Stufenhöhe 243 ± 12



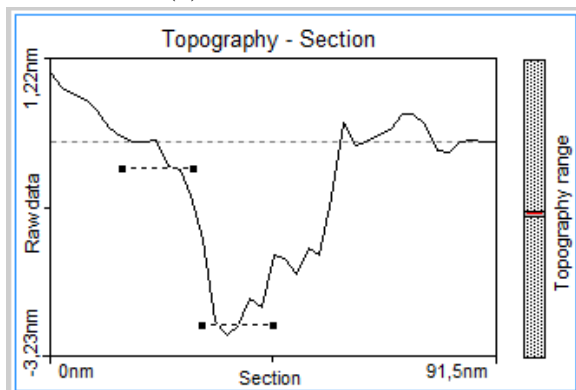
(d) Stufenhöhe 234 ± 12



(e) Stufenhöhe 959 ± 48



(f) Stufenhöhe 714 ± 36



(g) Stufenhöhe 935 ± 47

Abbildung 17: Bestimmte Stufen der Goldprobe

Literatur

- [1] W. P. Davey. »Precision Measurements of the Lattice Constants of Twelve Common Metals«. In: *Phys. Rev.* 25 (6 1925), S. 753–761. DOI: 10.1103/PhysRev.25.753. URL: <http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRev.25.753>.
- [2] H. R. Gerd Binnig. *SCANNING TUNNELING MICROSCOPY - FROM BIRTH TO ADOLESCENCE*. 8. Dez. 1986. URL: https://moodle2.uni-wuppertal.de/pluginfile.php/223710/mod_resource/content/1/STM.pdf (besucht am 23.09.2015).
- [3] *Graphit*. URL: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/GraphitGitter4.png> (besucht am 23.09.2015).
- [4] *Graphit*. URL: <https://de.wikipedia.org/wiki/Graphit> (besucht am 23.09.2015).
- [5] *Iridium*. URL: <https://de.wikipedia.org/wiki/Iridium> (besucht am 24.09.2015).
- [6] *Tunneleffekt*. URL: <https://de.wikipedia.org/wiki/Tunneleffekt> (besucht am 23.09.2015).
- [7] *Tunneleffekt - Wellenfunktion und Potential (1)*. URL: <http://www.semibyte.de/wp/graphicslibrary/gl-physics/tunneleffekt> (besucht am 23.09.2015).